

DERWENT-ACC-NO: 1988-087450

DERWENT-WEEK: 198813

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: X=ray mask mfg. method providing accurate
pattern uses gold-plated stencil of hydrogenated boron
nitride or hydrogenated carbonised boron nitride etc.

NoAbstract Dwg
1/1

INVENTOR: NAKAISHI M; YAMADA M

PATENT-ASSIGNEE: FUJITSU LTD[FUIT]

PRIORITY-DATA: 1986JP-180208 (August 1, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
<u>JP 63037621 A</u>	February 18, 1988	JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
JP 63037621A	N/A	1986JP-180208
August 1, 1986		

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC	DATE
CIPP	G03F1/00	20060101
CIPS	G03F1/16	20060101
CIPS	H01L21/027	20060101
CIPS	H01L21/30	20060101

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: X=RAY MASK MANUFACTURE METHOD ACCURACY PATTERN GOLD
PLATE STENCIL

HYDROGENATION BORON NITRIDE CARBONISE NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: L03 P84 U11

CPI-CODES: L03-H04C; L04-C06A;

EPI-CODES: U11-C04A3;

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-37621

⑬ Int.Cl.⁴H 01 L 21/30
G 03 F 1/00

識別記号

3 3 1
G C A

庁内整理番号

M-7376-5F
V-7204-2H

⑭ 公開 昭和63年(1988)2月18日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 X線マスクの製法

⑯ 特 願 昭61-180208

⑰ 出 願 昭61(1986)8月1日

⑱ 発 明 者 山 田 雅 雄 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内⑲ 発 明 者 中 石 雅 文 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑳ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

㉑ 代 理 人 弁理士 青 木 朗 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

X線マスクの製法

2. 特許請求の範囲

1. 金めっきによってX線マスクの吸収体パターンを形成するときに使用するめっきステンシルを、水素化：窒化ほう素、または水素化：炭化窒化ほう素、または窒化けい素とすることを特徴とするX線マスクの製法。

2. 金めっきの後に、めっきステンシルをめっきベースとともに除去して、めっきした金吸収体のみを残す、特許請求の範囲第1項記載のX線マスクの製法。

3. めっきベースをX線透過性の導電性材料で形成し、金めっきの後に、めっきベースおよびめっきステンシルを、めっきした金吸収体とともに残す、特許請求の範囲第1項記載のX線マスクの製法。

4. めっきベースを酸化インジウム：すずとする、特許請求の範囲第3項記載のX線マスクの製

法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体装置の製造において使用するのに適するX線マスクの製法に関する。

(従来技術)

X線マスクの吸収体パターンは通常金をめっきするか、またはタンタル、もしくはタングステンを蒸着させて形成する。金をめっきして吸収体とするときは、X線透過性メンブレンの上に、パターンニングされためっきステンシルを形成し、これをマスクとして金をめっきする。めっきステンシルの材料として、従来はホトレジストまたはポリイミドをスピンコートし、これをパターンニングしていた。しかし、これらの有機物は強度が弱いので、パターンが倒れたり、またパターンニングするときに剥離し易い欠点があり、さらに、金めっきの後に有機物質のステンシルを残してそのままX線透過領域とするX線マスクを形成するときは、

X線照射によってこれらの有機物質が速かに劣化する欠点がある。

〔発明の解決しようとする問題点〕

金めっきによってX線マスクの吸収体パターンを形成するときに使用するめっきステンシルを、強固で変形しない物質から形成することが問題である。

〔問題点を解決するための手段〕

上記問題点は、金めっきによってX線マスクの吸収体パターンを形成するときに使用するめっきステンシルを、水素化：窒化ほう素、または水素化：炭化窒化ほう素、または窒化けい素とすることを特徴とするX線マスクの製法によって達成することができる。

金めっき吸収体パターンを形成するときに使用するめっきステンシルは、めっき後にこれを除去すればよい。またはめっきベースをX線透過性の導電性材料、たとえば酸化インジウム；すず

(ITO)として、めっき後にステンシルをめっきベースとともに残したまま金めっきX線マスクとすることもできる。

〔実施例〕
〔実施例1〕

(a) シリコン基板1の1つの面の周辺部にアルミナリング2を接着した後に、基板1の反対側の面に、プラズマ化学気相成長(PCVD)によって、水素化：窒化炭化ほう素の厚み $4\mu\text{m}$ のX線透過性メンブレン3を成膜した。リング2の下部分を除いたシリコン基板1を、ふっ酸・硝酸・酢酸の混酸でエッチングして、リング2に囲まれた領域のメンブレン3を露出させた。リング2とは反対側のメンブレン3の面に、タンタル/金/タンタルを順次蒸着して、厚み約 700\AA のめっきベース4を形成し、この上に厚み約 $1.5\mu\text{m}$ の水素化：窒化炭化ほう素5をPCVDによって成膜し、この上に厚み約 $0.1\mu\text{m}$ のシリコンオングラス(SOG)6、次に厚み約 $0.5\mu\text{m}$ のレジスト7をそれぞれスピンコートして、多層レジストを成膜した

(第1図a)。

(b) 電子線露光によって、レジスト7をパターンニングし、これをマスクとして、^{炭化}ふっ素プラズマエッチングによって水素化：窒化ほう素膜5をパターンニングしてめっきステンシル5'を形成した(第1図b)。

(c) めっきステンシル5'をマスクとして、めっきベース4の上に厚み約 $1.0\mu\text{m}$ の金をめっきしてX線吸収体とした(第1図c)。

(d) ふっ素系プラズマエッチングによってステンシル5'を除去し、さらにアルゴンイオンミリングによってめっきベース4も除去して、X線マスクを完成した(第1図d)。

〔実施例2〕

実施例1の工程(a)において、めっきベース4のタンタル/金/タンタルの代りに、X線透過性であって導電性を有する酸化インジウムすず

(ITO)を使用したことの他は、実施例1の工程(a)と同様にして、めっきステンシル5'を

形成し、(第1図b)、これをマスクとしてめっきベース4の上に金めっきしてX線吸収体とした(第1図c)。

この実施例では、めっきベース4およびその上のめっきステンシル5'が、ともにX線透過性を有するので、これらを除去することなく第1図(c)の形状のまま、X線マスクとして使用することができる。

これらの実施例では、めっきステンシルの材料として水素化：窒化炭化ほう素を使用したか、水素化：窒化ほう素または窒化けい素を使用しても同様な結果が得られる。

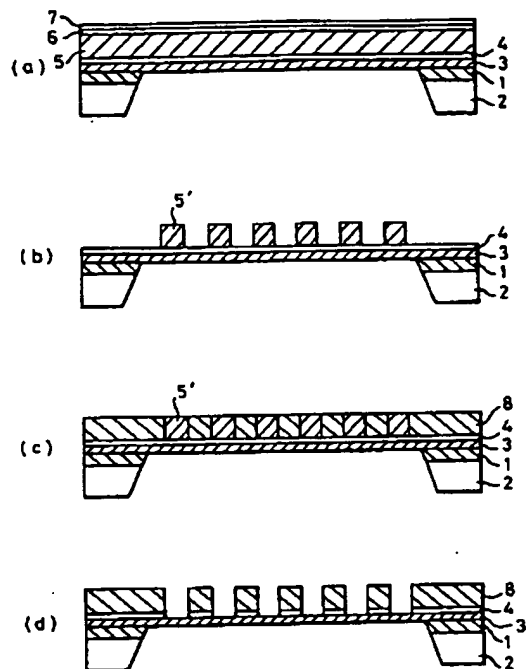
〔発明の効果〕

本発明の金めっきステンシルを使用して製造したX線マスクは、パターンの精度がよく、欠陥密度が 0.1 個/ cm^2 以下と少なかった。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a~d)は本発明のX線マスクの製法の実施態様を示す工程図である。

- 1…基板、 2…リング、
 3…メンブレン、 4…めっきベース、
 5…ステンシル材料、 5'…ステンシル、
 6…シリコンオングラス、
 7…ホトレジスト、
 8…めっきした金吸収体。



X線マスクの製造工程図

第1図

- 3…メンブレン 5'…めっきステンシル
 4…めっきベース 8…めっきしたX線吸収体

特許出願人

富士通株式会社

特許出願代理人

弁理士 青木 朋
 弁理士 西館 和之
 弁理士 内田 幸男
 弁理士 山口 昭之